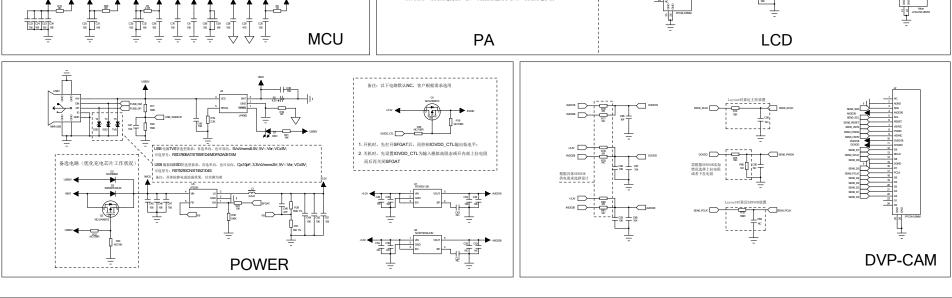
	版本	上更新说明								
[版本号									
}		V1.0 20210903 原始版本 V1.1 20220429 更新了防浪涌、静电保护措施								
L	V 11	20220423	IR.							
				1				I		
_		6	5		4	3		2	1	
							-			
		PFESO(NAURRA NA. Galdafa33/Addimensi)/,		420/-	注:根据具体需求选择单/双麦进行设计 而要求较高情况下可调整IO采用数字码	关于电源控制: (关机低功耗) SFGAT用作FLASH电源及外部3.3	N DCDC的使能脚	注: 软关机后是通过下降沿唤醒主控的, 开关机键值最好定为0V. 若按键较多时, 为防止临近按键误判到唤醒, 开关机按键	TF卡使用1线模式	
					DACADO DA			可定义为长按操作或独立使用有WKUP功能的IO		
D		Ves9V, Ved组织结杆,可这型号:		UMPT_TX				ioco ♠	2 2 2 200 23 200 200 200 200 200 200 200	D
		ESD113.81/RST9725DC/ST0021D4S/ST4521D4S		ingtaco 词试串口	RES 33K			28 D 3	SD-TFCar vas 5 SD-Cax S	
		10P AC2000A,CFN70E	8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ĩ	Ť :	2. 94V	DI	
		*** Two True	WP/CCCC ACCEPTED CONTROL SECURITY SECUR			20 C 1 C VC		2. 60V	00 9 000,00T	
		各往: 具体防静电效果, 以实搬为唯一	an 5		REZ	990,0 2 50001 0387000 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	SPR_CLK SPR_DD	2. 25V	2 2 E 2 SD HOM 必要时,数据时钟线预留ESD管设计	
		WF/DD14 2 WF/DD14 WF_DD2 4 WF/DD2	SEND, DOPPO	SIN0,00 SIN0,01			C7 NCOSP	77 - MA TAK 1. 90V		
		DAD 5 10/00 100 100 100 100 100 100 100 100 1	SEM ORPHO SEM	SINQ DI SINQ DI SINQ DI		=	÷	FOENO OV	PR TR	
		LCD_DCUK 9 POSICIO_CUMMA. LCD_DCU 9 POSICIO_DCUMA. LCD_DCU 90 POSICIO_DCUMA.	DS ΔC7016Δ SENS_CERNS 46	200,05 200,07 200,07 200,04				Ť 102	C15 C16 196	
		LCD_CD 11 PCSLCD_CDIMA_E LCD_CD 12 PCSLCD_CDIMA_E LCD_CD 12 PCSLCD_CDIMA_E PCSLCD_CD_MMA_C	(QFN76) SENS_SNACSSASS	SINQ VOIN SINQ) SINN ID/CD	MIC	FLASH		KEY = =	TF [÷]	
		LCO_DS		FUSBL DR FUSBL DM	IVIIC	ILAGII	<u> </u>		j	
		500_CLK 11 PRISCO_CLK 500_CMD 12 PRISCO_CMD	500 41 VMAY 45 DOCKMAY 35	SW SMCJ DCXDD4			各注1. 参老原西	理图默认采用RGB屏,RGB屏与MCU屏两者二选一		
		1 0 pr 5885 8 5855 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8						的WR/RD及Data信号有固定IO(具体可参考芯片规格书),其他信号可	「使用GPIO控制	
С		11	Praedicity Praedicity Praedicity Praedicity Praedicity Processor P		MITE 1 1513 2	MUTE OUT 7 gs.	Ì			С
			8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		DEC	894 VOD 5 5 504	8位	立MCU屏	8位RGB屏	
					DACK RS SEC SEC SEC SEC SEC SEC SEC SEC SEC SE	CD CD CD CD	1			
			WHT.TX DWO SHILD SHOOT NATE NATE NATE NATE NATE NATE NATE NAT		客户根据	需求选择功放型号及调整电路	VIDA VIDA	1 VCC (250 A) 430 (450 A) 430	IID,K 1 MID- IID,A 2 MID- 2 MID- 3 MID-	
		晶振速型基本要求(晶振影响RF性能) 1. 频率误差, 正负10ppm 2. 负载电容。12pF(外部预留医配电容位置作为备用)	DODOW-	11 20 20 20 V	C72 R11	R6 C21 .336, 105	MCU, RST MCU, CS	4 k	123V 4 VGD 5 00 100,001 6 01	
		WF.000 1 000 000 4			REC.P L		MCU_RS MCU_WR	5 NR	C75 LCD, D0 8 D0 LCD, D4 T0 D4	
		2 QND 0500 3 WF_0500	20000	100 100	PAGE 1 TO NO.		MCU_D0 MCU_D1 MCU_D2	11 00 12 12 12 13 13 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	100,00 100 100 100 100 100 100 100 100 1	
		WF_GGG CD CD	22300 E E E	DCVDD14的DCDC电路要靠近芯片故置 此电容地与PGND(PIN42)走线尽可能短	REC.N PAGE	25 PEDOT2	MCU_DA MCU_DA	M DA	RIO LCD_DCLK IS COLK	
		W-0000 NCT	不绝时钟的可以省排32.768K品报	(电容地与PGNL(PIN4Z)定线水可能短	CA GR	∞ 必要时,喇叭接口预留ESD管设计	MCU_D7 MCU_TE	17 UT TT	EDA LCC) JESTAC 15 HOTING NC LCC) JESTAC 17 VISIAC	
		WOON 0000 WOOD 00 000 000 000 000 000 000 000 000 0			喇叭端的差分回采电路(用于语音打断 1.电路参数的选择可根据功放、喇叭			19 KC 22 KC 23 KC 24 KC 22 KC 22 KC 23 KC 24 KC 25 KC 26 KC 27 KC	1 19 NC1 20 GMD	
				<u>↑</u>	2.默认采用一级的低通滤波,客户可根据性能需求添加二级的低通参数		 	23 NC 1985	9 9	
				لـــ			!	N FFCH-05MM	□ □ Value CCD-OUP-SOPN	
В				DA		÷		В		
٦				PA		1	LCD			
					•					
			16667							
		Usan J	, u	\$ SE	主:以下电路默认NC,客户根据需求选用				. [2	
		8 8 av	OM R17 S PROG CHRS 1 2 42/+		123V (123V (ALCOIS D	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	ACCHE SENE,XCLIK SENE,XCLIK SENE,XCLIK	1 NC 2 ACMD 3 SENS, SENS	



Α